Fisica delle superfici e di film ultrasottili

Dr. Alberto Verdini

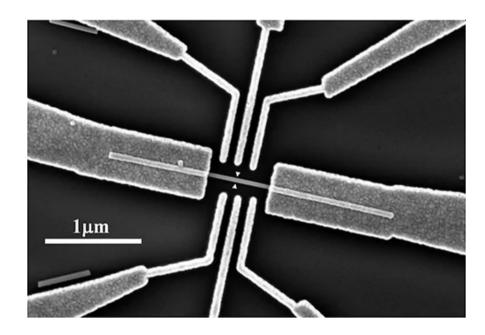
CNR-IOM

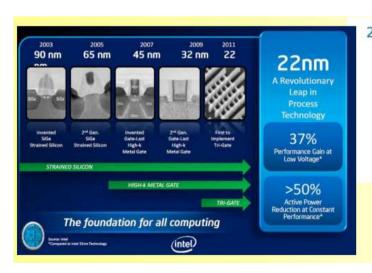
verdini@iom.cnr.it

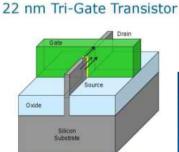


Wafer di Silicio – tecnologia anni '60

Transistor



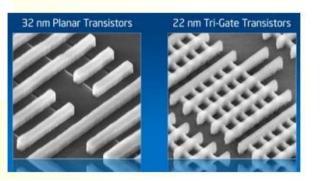




Legge di Moore: Il numero di transistor nelle CPU raddoppia ogni due anni

Logic/Foundry Process Roadmaps (for Volume Production)

	2016	2017	20:	18	2019	2020		2021	202	2
Intel	14nm+	10r (limit			10nm	10nm	•	10nm++		7nm
Samsung	10nm			8nm	2000 6000	18nm FDSOI 5n	m	4nm	3	inm
тѕмс	10nm	121	7nm nm		7nm+	5nm 6r	ım İ	5nm+	4nm	3nm
GlobalFoundries			22nm FOSOI	12nm finFET		12nm FDSOI	22n	m+ iOI 12nm+ finFET		
SMIC					14nm notes	12	tnm FET	8-1	Onm	
имс		14nm				22nm planar				



FRACTION OF ATOMS ON THE SUMFACE

L-20

NANOTECHNOLOGIES!

SURFACE FRACTION =

 $\frac{L^3 - (L - 2D)^3}{L^3}$

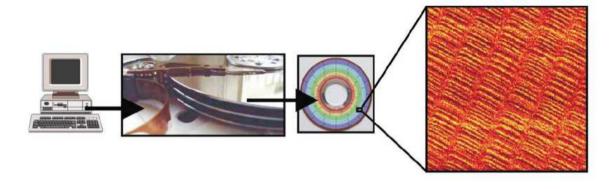
qa.

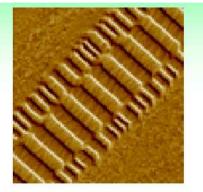
L	FRACTION			
1,um= 1000 nm	0.001 = 0.17			
0.1 um= 100 mm	0.012 2 1.29			
0.01 mm = 16 mm	0.115 x 11.59			
0.001 um = 1 nm	0.784 = 79,49			

Prof. C. Fadley School of Synchrotron Radiation Miramare, Trieste Italy 1999 There's Plenty of Room at the Bottom è il titolo di una presentazione di Richard Feynmann alla riunione dell'APS al Caltech il 29 dicembre 1959.



NANOTECHNOLOGIES!

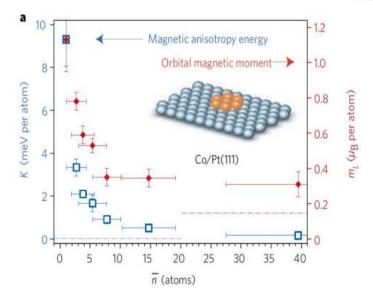




Magnetic hard drive (25 μm x 25 μm). Wires are about 2000 atoms wide.

Data Storage Magnetico



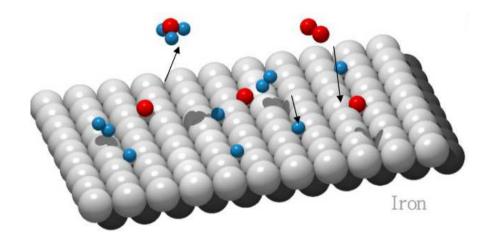


->Spintronica

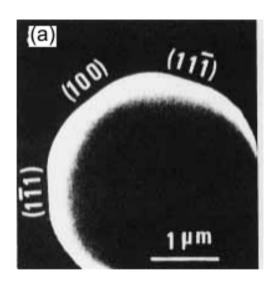
Processo Haber-Bosch (1910)

 $3H_2 + N_2 -> 2NH_3$

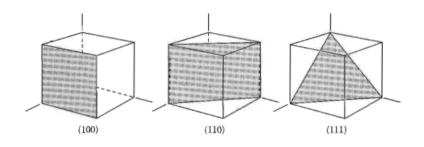
Catalisi eterogenea



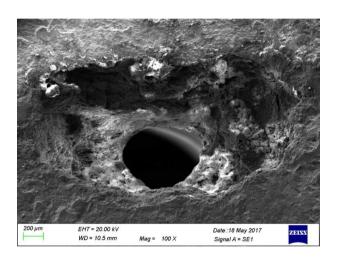
Processo utile per fertilizzanti usato ancora oggi mediante superfici di Fe



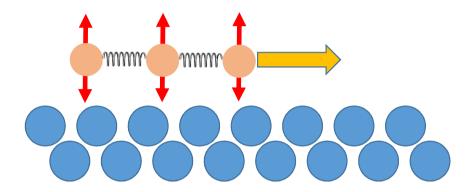
Particella di Pb

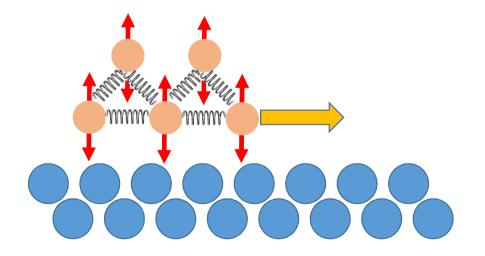


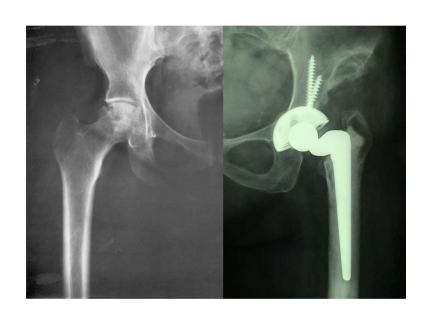
Corrosione



Attrito, adesione, Tribologia

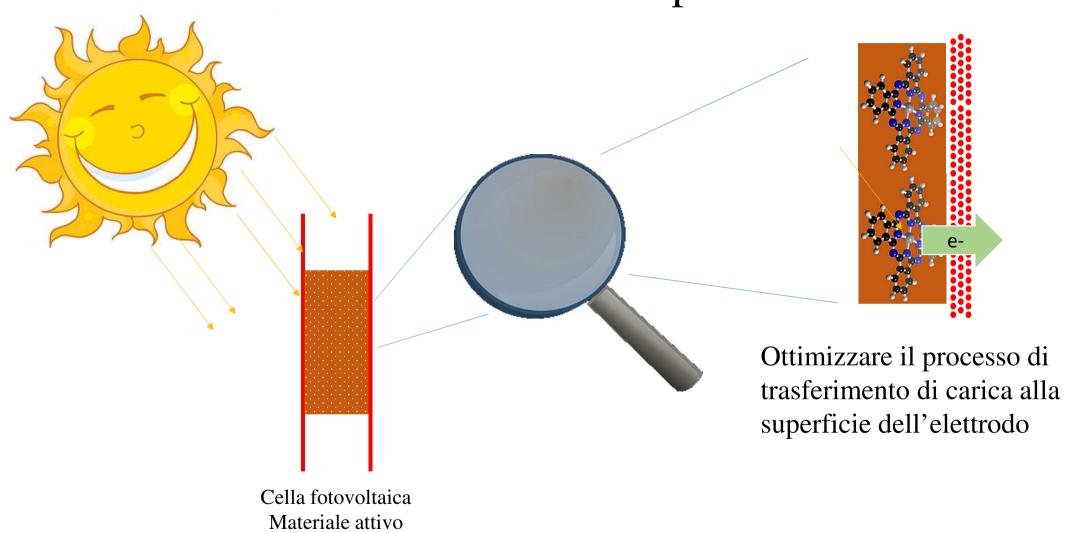






Scienza dei materiali

Medicina Rivestimento di materiali avanzati in protesi (composizione (metalli/polimeri/ceramica), attrito, rugosità, tasso di usura, resistenza ai graffi, durezza, biocompatibilità, ecc.)



Molecole organiche

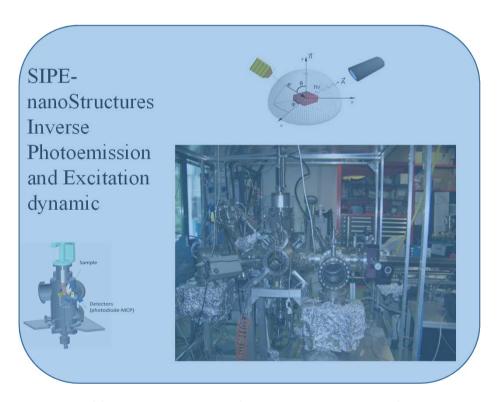
Fisica delle Superfici e sistemi modello

- Le superfici reali sono molto complesse e mal definite: policristalli, disordine, difetti,
- ➤ Dipendono dall'ambiente in cui si trovano
- > Impurezze

Come studiarle?

- Partire da sistemi semplici (UHV ultra alto vuoto)
- Studiare le superfici a «basso indice» di cristalli singoli
- Capire bene queste superfici "ideali" e poi introdurre difetti/irregolarità/disordine in modo controllato
- Rendere i sistemi gradualmente più complessi nello speranza di avere modelli sempre più vicini alla realtà

Attività di Ricerca @ Laboratorio Congiunto Superfici e Nanostrutture Dr. Alberto Verdini, Dr.ssa Maddalena Pedio, Prof. Giovanni Carlotti





ACROSS –Surfaces, Nanostructures, Electron Diffraction, Auger and UV Photoemission Spectroscopy

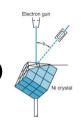


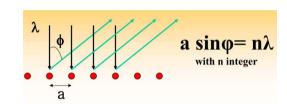
https://www.iom.cnr.it/research-facilities/facilities-labs/analytical-microscopy-and-spectroscopy/sipe/

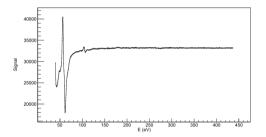
https://www.iom.cnr.it/research-facilities/facilities-labs/analytical-microscopy-and-spectroscopy/across/

Advanced Chamber for Surface Studies -> ACROSS

- Low Energy Electron Diffraction LEED
 + Auger
- Reflection High Energy Electron Diffraction - RHEED
- Electron Bombardment Cell for metals
- Cooled Multicell for organic molecules deposition
- Electron Analyzer + 2D detector
- UV Source
- (Monochromatized) X-ray Source

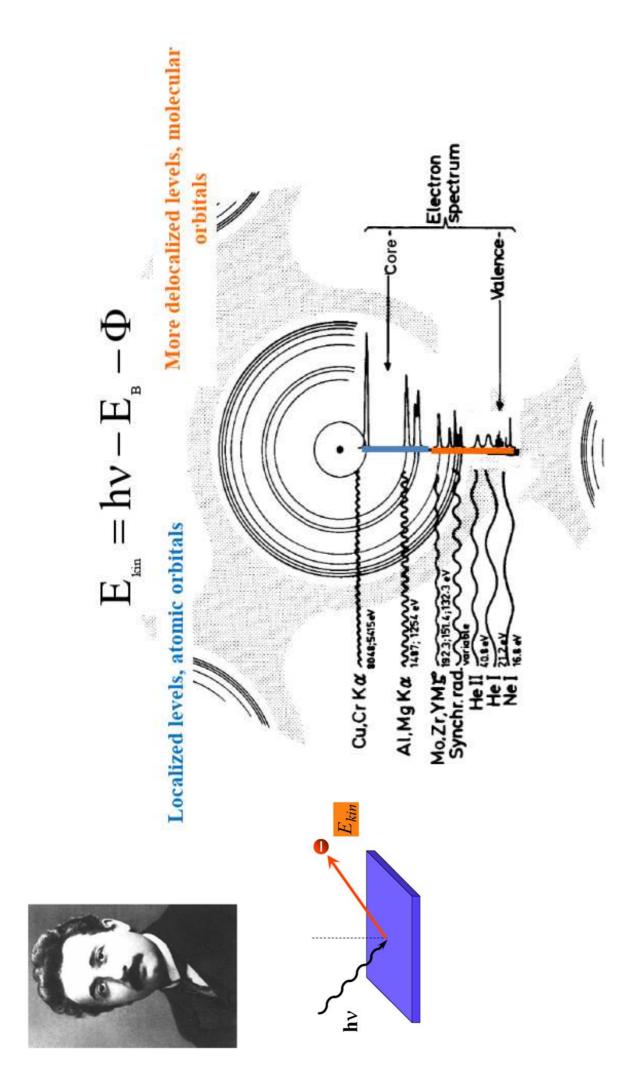




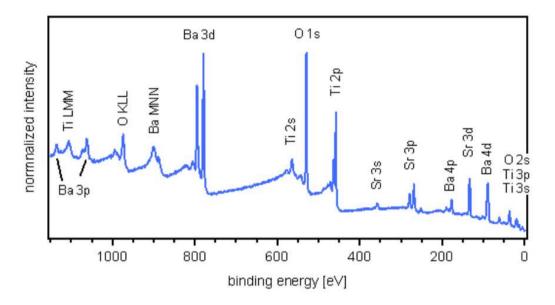




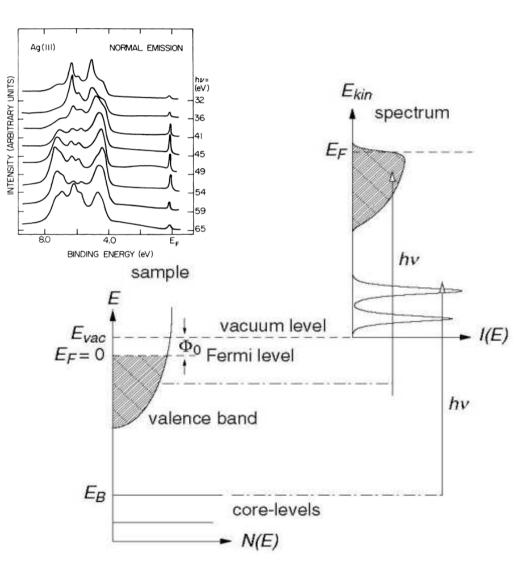




X-ray Photoemission Spectroscopy - XPS

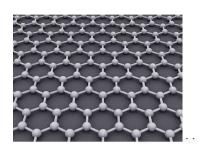


- Specificità specie atomica
- Stato chimico
- Proprietà elettroniche



Attività di Ricerca

Materiali 2D Monoatomici



Crescita pilotata dalla superficie

Graphene

Silicene

Germanene

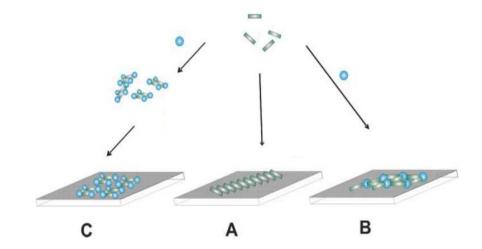
Stanene

Plumbene

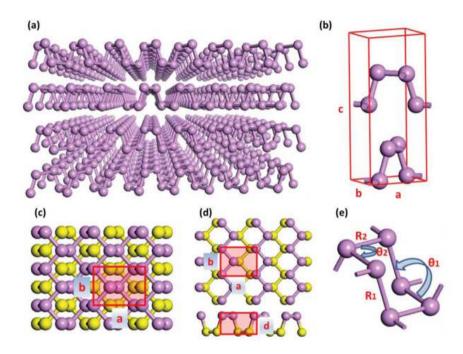
T	40.5	45.5	1.505	10,027	
				100000	helium 2
					Не
					4.0026
boron	carbon	nitrogen	oxygen	fluorine	neon
5	6	7	8	9	10
В	C	N	0	F	Ne
10.811	12.011	14.007	15.999	18.998	20.180
aluminium 13	silicon 14	hosphorus 15	sulfur 16	chlorine 17	argon 18
	and the second	100000	1 (12)(2)		2
AI	Si	P	S	CI	Ar
26.982	28.086	30.974	32.065	35.453	39.948
gallium	germaniun	arsenic	selenium	bromine	krypton
31	32	33	34	35	36
Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
69.723	72.61 tin	74.922	78.96	79.904	83.80
indium	1in 50	antimony	tellurium	iodine	xenon
49		51	52	53	54
In	Sn	Sb	Te	- 1	Xe
114.82	118.71	121.76	127.60	126.90	131.29
thattium	lead	bismuth	polonium	astatine	radon
81	82	83	84	85	86
TI	Pb	Bi	Po	At	Rn
204,38	207.2	208,98	[209]	[210]	[222]

Borophene

Phosphorene



Black Phosphorous



V. Sorkin et al. Critical Reviews in Solid State and Materials Sciences, 42, 1 (2016)

PHYSICAL REVIEW B 93, 035448 (2016)

Surface structure determination of black phosphorus using photoelectron diffraction

Luis Henrique de Lima, ^{1,*} Lucas Barreto, ^{1,2} Richard Landers, ¹ and Abner de Siervo ^{1,†}

¹Instituto de Física Gleb Wataghin, Universidade Estadual de Campinas, Campinas 13083-859, São Paulo, Brazil

²Centro de Ciências Naturais e Humanas, Universidade Federal do ABC, Santo André 09210-580, São Paulo, Brazil

(Received 16 November 2015; revised manuscript received 11 January 2016; published 26 January 2016)

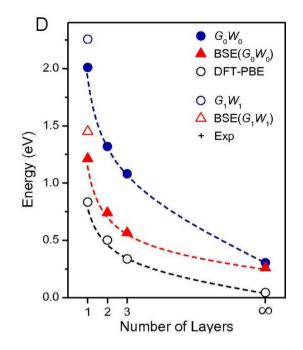
Applicazioni

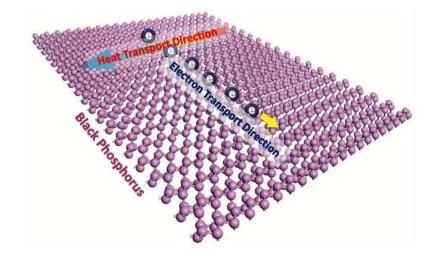
- Transistor FET
- Dispositivi Optoelettronici
- Celle solari
- Scissione fotocatalitica dell'acqua
- Batterie Li-ion
- Materiali termoelettrici
- Sensori

Black phosphorous principali proprietà interessanti:

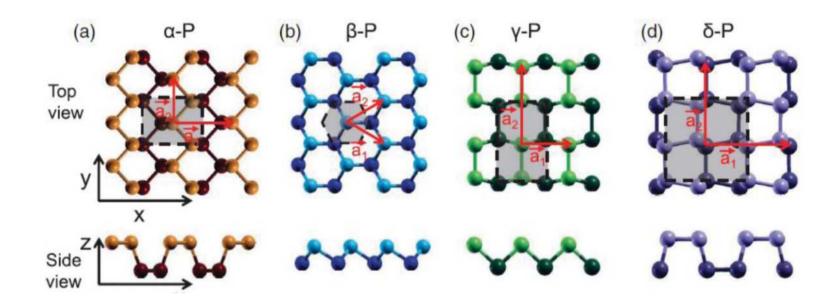
• La gap dipende dal numero di strati

 Anisotropia sul piano del trasporto di calore e di elettroni



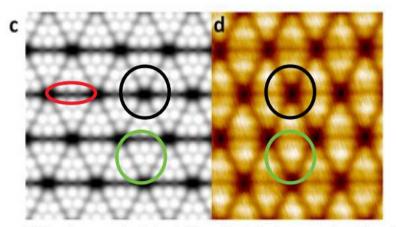


Molti possibili monostrati con diverse strutture



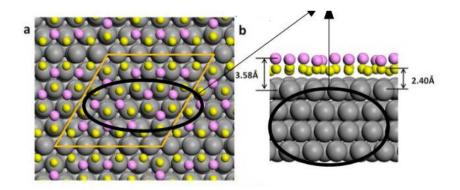
Fasi calcolate per un singolo strato di P

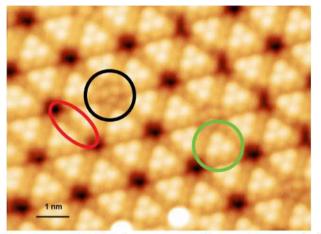
J. Guan et al, PRL 113, 046804 (2014)



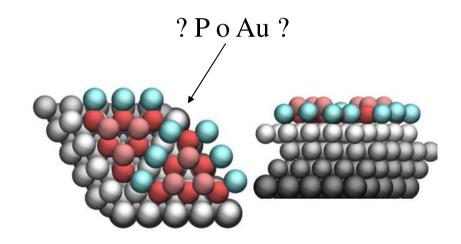
[1]J.L. Zhang et al., Epitaxial Growth of Single Layer Blue Phosphorus: A New Phase of Two-Dimensional Phosphorus, Nano Lett. 16, 4903-4908 (2016)

Struttura non stabile

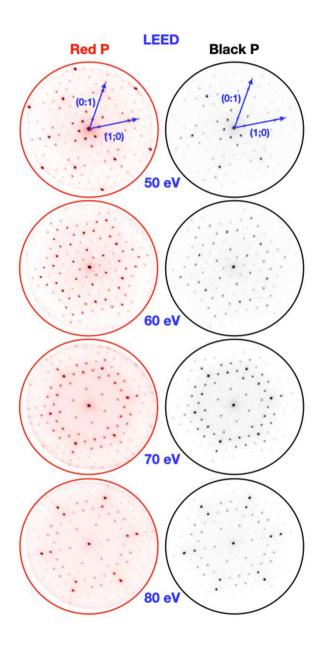




Our expSTM image - P₁₆ x 2 model



A. Sala @ IOM TS M. Peressi S. Dal Puppo @UniTS



Perché non usare il fosforo rosso (molto molto economico) invece di quello nero (molto costoso)?

Stesse Strutture



SI!



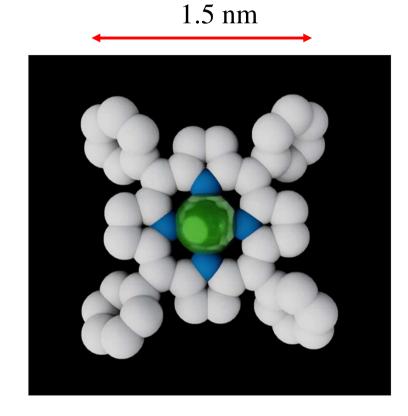
Abbassamento dei costi (anche ambientali) per la produzione di dispositivi

Porfirina (tetrapirrolo), molecola metallorganica -> semiconduttori organici

Funzionalizzabile mediante diversi ligandi Metallo al centro: Cu, Zn, Ni, Fe, Pd,

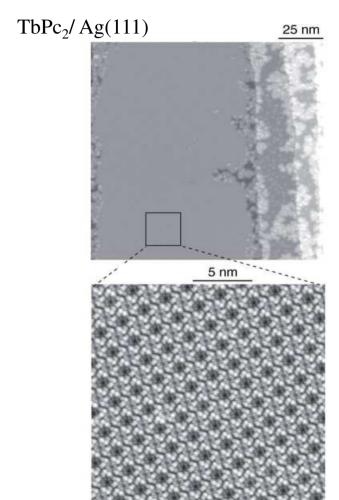
Applicazioni:

- Celle Solari
- Dispositivi elettronici a basso consumo
- Transistor molecolari
- Spintronica
- H₂ da Water Splitting
- Sensori
- Quantum Computing
- Terapie anti tumorali

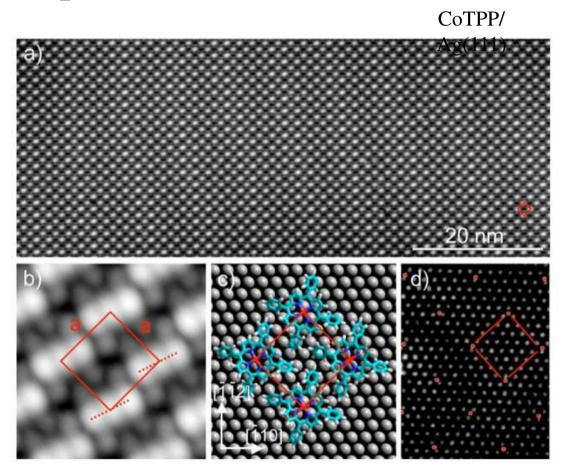


Presente nei sistemi biologici fondamentali Emoglobina, Clorofilla, F430,...

Autoassemblamento sulle superfici

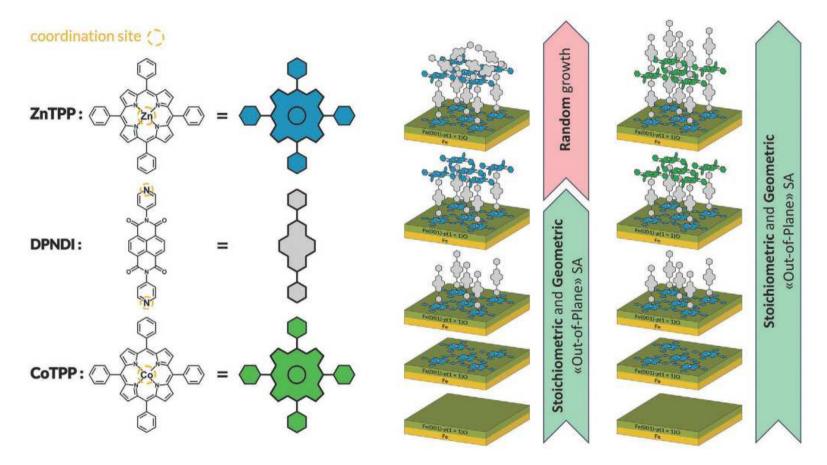


K. Diller et al. RSC Adv., 9, 34421 (2019) DOI: 10.1039/c9ra06803a



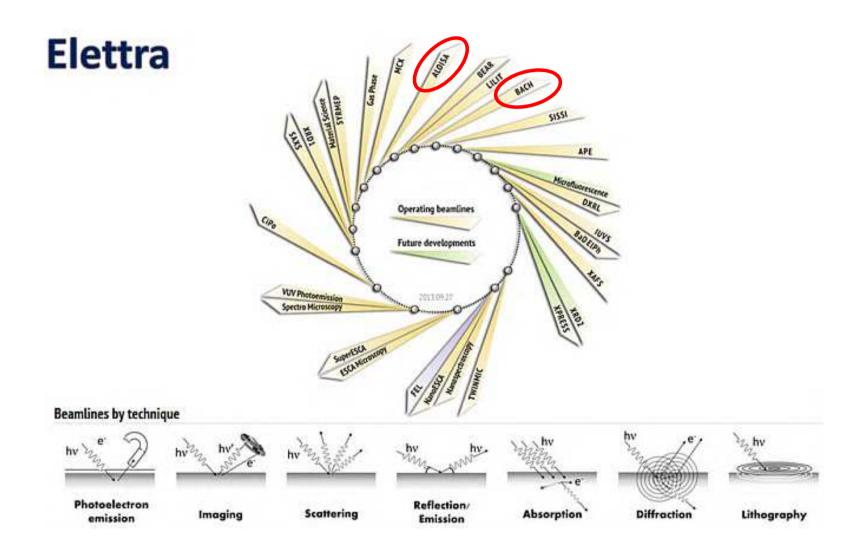
W. Auwarter et al. PRB 81, 245403 (2010, http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.81.245403

Autoassemblamento in 3D



A. Bossi, A. Orbelli Biroli @CNR-SCITEC MI G. Bussetti et al. @Polimi L. Floreano, L, Schio @CNR-IOM TS Adv. Funct. Mater. 2021, 31, 2011008

Attività presso Sincrotrone Elettra - Trieste



Possibili argomenti per le tesi triennali e magistrali

• Studio della crescita di P su superfici metalliche: Cu(111), Cu(100), Ni(111), Pt(111),....

Laboratorio/sincrotroni

- Studio delle interazioni monostrato di P con tetrapirroli
- Ottimizzazione della tecnica di spettroscopia UPS e XPS
- Ottimizzazione della strumentazione delle camere sperimentali motorizzazioni, acquisizione dati, automazione,...

Grazie per la vostra attenzione